

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

ИВАНОВ Сергей Викторович

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор

Директор ФТИ им. А.Ф. Иоффе (г. Санкт-Петербург), р. 24.06.1960, лауреат премии Ученого совета ФТИ (1988), дважды лауреат премии им. А.Ф. Иоффе (1999, 2017), лауреат премии им. Ж.И. Алферова (номинация нанотехнологии) Правительства Санкт-Петербурга (2020 г.)

Иванов С.В. - высококвалифицированный специалист в области физики и технологии полупроводниковых квантоворазмерных гетероструктур A_3B_5 , A_2B_6 и A_3 -нитридов, один из ведущих специалистов в мире в области технологии молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ), автор 637 научных работ, из них 10 глав в монографиях и 9 патентов, индекс Хирша – 39, число цитирований – более 12 000.

Основные научные результаты Иванова С.В.:

- развиты физические основы технологии МПЭ полупроводниковых гетероструктур с учетом сегрегационных явлений и упругих напряжений и применены к созданию впервые в России низкоразмерных гетероструктур широкого спектра материалов: узкозонных соединений A_3B_5 , широкозонных соединений A_2B_6 , A_3 -нитридов, получаемых МПЭ с плазменной активацией азота;

- созданы уникальные приборные квантоворазмерные гетероструктуры: сверхнизкопороговых лазерных диодов с отдельным ограничением в системе $AlGaAs$; первых в мире сине-зеленых лазерных диодов с квантовыми точками (КТ) $CdSe/ZnSe$; инжекционных лазерных конверторов $A_2B_6/InGaN$ желто-зеленого спектрального диапазона; светодиодов, лазеров и солнечно-слепых фотоприемников среднего УФ диапазона (250-350 нм) на основе гетероструктур $AlGaN/AlN$, однофотонных источников на основе КТ $InAs$, $CdSe$ и $CdTe$;

- разработана и экспериментально реализована оригинальная концепция когерентных гетеролаентных гетероструктур A_3B_5/A_2B_6 , позволяющая существенно расширить возможности конструирования опто-, микро- и спин-электронных приборов нового поколения.

Иванов С.В. – заведует базовой кафедрой ФТИ им. А.Ф. Иоффе в НИУ ВШЭ-СПб (с 2020 г.), подготовил 7 кандидатов физ.-мат. наук.

Иванов С.В. - член Диссертационных советов ФТИ им. А.Ф. Иоффе и СПбГЭТУ «ЛЭТИ», член программных и координационных комитетов регулярных международных конференций по физике и технологии полупроводников, 5 из которых проводились под его председательством в России, эксперт РНФ, член редколлегии журналов «Superlattices and Microstructures» и «Physica Status Solidi».

Государственные награды: благодарность Президента РАН в связи с 275-летием РАН, 1999 г.; Грамота Президиума РАН, 2013г.; благодарность губернатора Санкт-Петербурга, 2020 г.; медаль Минобрнауки России «За вклад в реализацию государственной политики в области технологического развития», 2021 г., медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2024 г.

Выдвижение: Иванов С.В. выдвинут кандидатом на должность директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе Ученым советом ФТИ им. А.Ф. Иоффе. Численность совета 40 чел., присутствовало 34 чел., за 34 чел., против 0 чел., недействительных бюллетеней – 0.